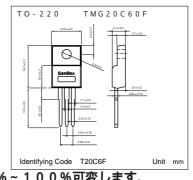
20A AC100V トライアック万能調光器キット

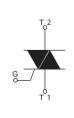
AC100V機器の出力パワーをVR1ケで、0%~100%可変します。

コントロールできるもの

電球・電熱器(ヒータ)・ACモータ・ハンダゴテ・ACファン(扇 風機)等







この万能調光器キットは、AC100Vの機器の出力パワーをVR1ヶで、0%~100%可変します。 コントロールできるもの 電球・電熱器 (ヒータ)・ACモータ・ハンダゴテ・ACファン (扇風機)等 二重ヒシテリシス防止回路採用によって、スムーズなコントロールができます。

専用プリント基板によって、小型に製作できます。(AC100Vを使用するため、基板は安全設計)

最大負荷電力は20A/40Aを各種用意しました。お求めいただいたキットには、ご指定の最大負荷電力まで

安全に使えるトライアックが1ヶついています。(100V20Aキット¥600、100V40Amaxキット¥800)

(トライアックを変えるだけで、最大負荷電力を変えることができます。) 〔部品内容〕

トライアック(20A): TMG20C60F(600V20A) または相当品

トリガ・ダイオード (ダイアック): N413 または相当品 D1~D4:200V 1Aシリコンダイオード×4(1N4007 1KV1A)

(10D2相当品・・・W03B・S5277G(400V)等)

2.2K · 1/2W(赤赤赤金) TNR/ZNR 07D151K × 2

1 5 K ・1/2W(茶緑橙金)×2

VR 250K Bカープ (直線変化)

CT:0.1µF(耐圧:50V以上)

(RF・CF1・CF2はオプションです。) モーター以外のランプ(抵抗負荷)のときはRF・CF1・CF2

を使わないほうがよい

コンデンサの容量 [104]なら 10×104 pF

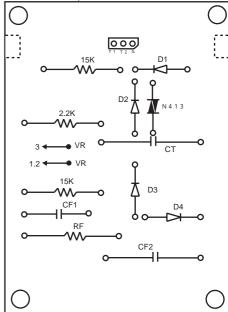
つまり0.1μF



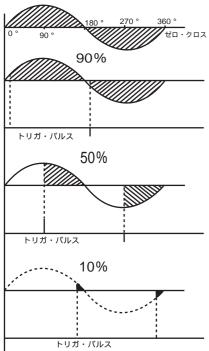
耐圧の記号

1H=50V 2A=100V 2B=125V 2D=200V 2E=250V 2G=400V

容量の記号 $124=0.12 \mu F$ 224=0.22 µ F



実線部分がT1-T2 ONの状態



*パワー素子(トライアック)には、使用上の さまざまな制約があり、負荷に合わせて過確 な保護対策を施さないと、思わぬところで、 破壊されてしまうので、充分な注意が必要です。 回路図に出来るだけの注意点を列挙したので 参考にしてください。

トライアック調光器回路の説明

右のグラフのようなコントロールをします。商用電源は交流(正磁波…Sin)ですから、1サイクル だけを例にして説明しています。波形のはじめを0°、終わりを360°とします。コントロールしていないときの波形の面積を100%とします。90%・50%・10%出力コントロール時の波形と、トリガ・ パルスの位置関係に注目して下さい。トリガ・パルスが 0° (又は 180°)から少しずつ遅れて出てい ます。この遅れている時間がコントロール量を決定しています。例えば、50%コントロールの場合 サイン波の頂点でトリガが出ています。これは導通角90°のポイントで制御するという表現をします。 (トライアックでの、このような電力制御を、導通角制御、又は位相制御といいます。) トリガ・パルスがトライアックのG(ゲート)に印加されると、T1-T2はOFF状態からON状態になり 負荷に電流を供給します。ゼロ・クロス・ポイント(0°・180°・360°…)になると、ONからOFFに なり次のトリガ・パルスを待ちます。トリガがかからなければそのままOFFを保ち続けます。 負荷に電流は供給されません。

トリガ・パルスはトリガ・ダイオードによって作ります。トリガ・ダイオードはブレイク・オーパ電圧 VB0 (26V~40V)を越えると、パルス状のプレイク・オーバー電流(IB0)を流します。これがトライア ックのGをトリガします。(トリガ・ダイオードは交流波形に対して、反応します...極性がありません) VRとCTによって、VBOに達するまでの時間を可変します。CRによる時定数回路です。 VRとCTの関係は、おおよその目安で、

50 K VR: 0.47 μ F

100 K V R: 0.22 μ F

VR: 0.1 µF 最適値 200 K

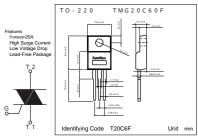
(コントロールしにくい場合には、コンデンサの容量を増減 してみる。実験をいろいろしてみると

~ をよく理解できると思います。)

*CTが小さく、RTが大きいほうがスムーズにコントロールしやすいですが、トライアックのG電流の 関係で、1M ・0,047マイクロFが限界です。これ以上だと、G(ゲート)をトリガ(駆動)できま せん。

Electrical Characteristics

TMG20C60F



Symbol	Item	Reference	Ratings	Unit
VDRM	Repetitive Peak Off-State Voltage		600	V
IT RMS	R.M.S. On-State Current	Tc 66	20	Α
ITSM	Surge On-State Current	One cycle, 50Hz/60Hz, Peak value non-repetitive	183/200	A
l²t	I't for fusing		165	A ² S
PGM	Peak Gate Power Dissipation		5	W
Pg av	Average Gate Power Dissipation		0.5	W
Igw	Peak Gate Current		2	A
V _{GM}	Peak Gate Voltage		10	٧
Viso	Isolation Breakdown Voltage R.M.S.	A.C. 1minute	1500	٧
Tj	Operating Junction Temperature		40 125	
Tstg	Storage Temperature		40 150	
	Mass		2	0

	LIGULIUA	I GIIdidGEIISIIGS					
	Symbol	Item	Reference	Ratings			Unit
				Min.	Тур.	Max.	Oill
	IDRM	Repetitive Peak Off-State Current	VD=VDRM, Single phase, half wave, Tj 125			2	mA
1	VTM	Peak On-State Voltage	It 30A, Inst. measurement			1.4	٧
11	I _{GT1}	1	- Vo 6V R∟ 10			30	mA
11	I _{GT1}	2 Gate Trigger Current				30	
11	I _{GT3}	3 Gate myger current					
11	I _{GT3}	4				30	
11	V _{GT1}	1				1.5	٧
11	V _{GT1}	2 Gate Trigger Voltage				1.5	
11	V _{GT3}	3 Gate Higger Voltage					
11	V _{GT3}	4				1.5	
11	VGD	Non-Trigger Gate Voltage	Tj 125 Vp 1 ₂ Vprm	0.2			٧
1	dv/dt c	Critical Rate of Rise of Off-State Voltage at Commutation	Tj 125 di/dt c A/ms VD 2 $_3$ VDRM	10			V/ s
H	H	Holding Current			25		mA
IJ	Rth	Thermal Resistance	Junction to case			2.5	/W

負荷

'1 V R

СТ

